2U3UUSUUF 2UUCUՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՉԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 65, №1, 2012 Химический журнал Армении

СТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ BaO–B2O3–2AlF3·3LaF3

К. А. НАЛБАНДЯН

Институт общей и неорганической химии им. М.Г. Манвеляна НАН Республики Армения Армения, 0051, Ереван, ул. Аргутяна II-ой пер. дом 10 E-mail: nalkar2007@yandex.ru

Поступило 16 XII 2011

Осуществлена направленная кристаллизация стекол системы BaO-B₂O₃-2AlF₃·3LaF₃. Для монофазной кристаллизации стекол выбран двухступенчатый режим термообработки. В результате структурных и физико-химических исследований выявлено, что для получения сегнетоэлектрических стеклокристаллических материалов (СКМ) наиболее оптимальной совокупностью свойств обладает стекло состава BaLa₃Al₂B₆(O₁₀,F₁₅. Изучены диэлектрические свойства СКМ, полученных в результате направленной кристаллизации данного стекла. Выявлено, что максимальные значения ((≥10000) имеют стеклокристаллические образцы, степень кристалличности которых ~85 %, а длительность термообработки – 30 ч. Основываясь на результаты рентгеноструктурных и ИК-спектроскопических исследований соединения BaLa₃[F₄/AlB₃O₅]₂F₇, предложена возможная пространственная структурная модель данного соединения.

Рис. 4, библ. ссылок 10.

В настоящее время сегнетоэлектрические материалы получают из монокристаллов (в основном из перовскитов) и их твердых растворов, синтез которых требует высоких температур, сложной аппаратуры и технологии, и приводит к низкому выходу конечного продукта [1].

Весьма перспективным направлением является синтез сегнетоэлектрических стеклокристаллических материалов (ССКМ) технологией направленной кристаллизации стекол определенного состава, способствующей получению материалов, сочетающих одновременно достоинства стекол и кристаллов. ССКМ с полярной структурой, отличающиеся высокими диэлектрическими и нелинейно-оптическими свойствами, которые сопоставимы с их монокристаллическими аналогами, представляют большой практический интерес в различных отраслях электроники и оптики.

В настоящее время известно ограниченное число стеклообразующих систем (Li₂O-SiO₂, Li₂O-B₂O₃-SiO₂, BaO-TiO₂-SiO₂-GeO₂, BaO-B₂O₃-SiO₂, BaO-Al₂O₃-SiO₂, PbO-GeO₂ и.т.д.) для получения полярных ССКМ [2,3].

Если учесть, что алюмоборатные, в частности фторалюмоборатные, системы мало изучены для получения на их основе ССКМ, а также возможность изоморфного замещения ВО4 и AlO4 групп в структуре алюмоборатных стеклообразных материалов, то актуально способом направленной кристаллизации получить недорогие стеклокристаллические материалы аналогичных по структуре боросиликатов, свойства которых сопоставимы с их более дорогими монокристаллическими аналогами [4,5].

Экспериментальная часть

Варка стекол производилась в электрической печи при температуре 950÷1150°С, в платиновом тигле с продолжительностью 30÷45 *мин*. Для синтеза стекол применялись химически чистые вещества: борная кислота (H₃BO₃), оксид бария (BaO), фториды алюминия (AlF₃) и лантана (LaF₃). Учитывая высокую летучесть соединений бора и фтора, использовался предварительно синтезированный метаборат бария BaB₂O₄. Фториды AlF₃ и LaF₃ вводились в шихту в виде впервые синтезированного нами соединения 2AlF₃·3LaF₃ (плавится конгруэнтно при 1130 °C), что позволило при варке стекла уменьшить потери от 3÷5 до 0.8÷1 масс.%.

Дифференциально-термический анализ (ДТА) стекол производился в платиновом тигле на дериватографе «Q-1500» (эталон Al₂O₃), скорость нагрева – 15°С/*мин*.

Рентгенофазовый анализ (РФА) закристаллизованных стекол проведен на дифрактометре «ДРОН 2.0» (λ=1.542 Å, излучение CuK₁, никелевый фильтр), под углом 10°≤20≤70°, скорость съемки – 2° мин⁻¹.

ИК-спектроскопическое исследование закристаллизованных стекол проводилось на спектрофотометре «IR-75» в диапазоне 1500÷400 *см*⁻¹, скорость съемки – 160 *см*⁻¹. мин⁻¹.

Плотность определялась методом гидростатического взвешивания в дистиллированной воде при комнатной температуре с точностью ±1.5·10⁻³ *г/см*³.

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) измерялся на дилатометре «ДКВ-4» при скорости нагрева 3÷3.5°С·*мин*⁻¹, точность определения ТКЛР в интервале 20÷300°С составляла ±3·10⁻⁷°С⁻¹.

Диэлектрическую проницаемость (ε) и диэлектрические потери (tgδ) определены на универсальном устройстве «Е7-11», электроды серебряные.

Результаты и их обсуждение

В результате структурных и физико-химических исследований стекол системы BaO-B₂O₃-2AlF₃(3LaF₃ выявлено, что для получения СКСМ практического значения оптимальной совокупностью свойств обладает стекло состава BaLa₃Al₂B₆(O₁₀,F₁₅).

По данным РФА, в результате кристаллизации стекла указанного состава образуются как сложные фторборатные соединения, так и фториды. На кривой ДТА стекла состава BaLa₃Al₂B₆(O₁₀,F₁₅) ярко выражены два экзотермических эффекта с температурными максимумами при 750 и 930°С. Высокотемпературный экзотермический эффект соответствует выделению кристаллического соединения BaLa₃[F₄/AlB₃O₅]₂F₇, а низкотемпературный – Ba₂La₃[F₆/AlB₇O₁₀]₂F₄.

Для монофазной кристаллизации стекла выбран двухступенчатый режим термообработки. Термообработке подвергались образцы толщиной 2÷2.2 мм и диаметром 14÷15 мм. Температура первой ступени термообработки, при которой образуется максимальное количество центров кристаллизации (Тоцк – 550±10°С), определялась на основе температуры размягчения стекла (535°C) исследованием температурной области, лежащей на 50÷150°С выше и ниже этой температуры с температурным шагом 50°С. За показатель принимались ТКЛР и плотность закристаллизованного стекла. Температура второй ступени, при которой наблюдается максимум скорости роста кристаллов (Тмрк - 930±10°C), определялась по высокотемпературному экзоэффекту на кривой ДТА (рис. 2 кривая, исходного стекла) исследуемого стекла. Длительность термообработки (т) для образцов составила 6÷30 ч, при этом первая стадия длилась приблизительно в два раза меньше, чем вторая. Стекла до температуры Тоцк нагревались со скоростью 8÷10°С/мин. Образцы от температуры Тоцк до температуры Тмрк нагревались со скоростью 18÷20°С/*мин*, которая позволила в полученном СКМ минимизировать фазы Ba2La3[F6/AlB7O10]2F4 (a образование нежелаемой также других фторборатных и фторидных соединений). Увеличению количества основной кристаллической фазы в ситалле способствует также увеличеступени термообработки. Сравнение ние времени второй интенсивностей основных дифракционных максимумов соединений ВаLаз[F4/AlB3O5]2F7 и Ва2Lаз[F6/AlB7O10]2F4 (рис. 1а) показало, что увеличение времени термообработки приводит к увеличению высокотемпературной фторалюмоборатной фазы. При этом увеличивается также общее количество кристаллической фазы, о чем можно судить по увеличению приращения плотности и уменьшению значений ТКЛР термообработанных стекол (рис. 2).



Рис. 1. Дифрактограммы (а) и ИК-спектры (б) поглощения термообработанного при 930°С стекла ВаLa₃Al₂B₆(O₁₀,F₁₅) при разных экспозициях термообработки: 1, 1 – 30 ч; 2, 2 – 6 ч.

Из ИК-спектров (рис. 1б) этих же образцов видно, что при больших значениях τ (≥30 ч) поглощения в области 1350÷1150 см¹, характерные для состояния бора в тройной координации, практически отсутствуют. Слабое поглощение с максимумом ~1150 см¹ связано с проявлением колебаний связей В(O,F)3 групп в остаточной стекловидной фазе. Увеличение общей интенсивности и смещение центра максимума поглощения от 840 до 860 см¹ свидетельствуют об усилении связей В-О и В-F и увеличении количества В(О,F)4 групп. Существенным образом меняется характер поглощения в области 550÷730 см¹, где проявляются валентные колебания алюминатных оксифторидных групп [6,7]. При длительной термообработке в спектре практически отсутствуют полосы поглощения в области 600(680 см¹, что связывается с переходами Al(O,F)6 [Al(O,F)4. Однако незначительная часть алюминия остается в шестерной координации, учитывая образование слабовыраженного плеча в этой же области, обусловленного колебаниями связей в Al(O,F)6 группах. Следовательно, есть основание считать, что в синтезированном СКМ ионы В³⁺ и Аl³⁺ входят в структуру кристаллической фазы BaLa3[F4/AlB3O5]2F7 преимущественно в четверной координации, образуя тетраэдры B(O,F)4 и Al (O,F)4 [8].

На рис. 2 приведены кривые ДТА, зависимости плотности и ТКЛР исходного и термообработанных стекол от времени термообработки и объемной доли кристаллической фазы (V_{крист.}/V_{СКМ} =f) в стеклокристаллическом материале.



Рис. 2. а – кривые ДТА образцов при разных соотношениях $V_{\mbox{\tiny крист.}}/V_{\mbox{\tiny CKM}}$, б – зависимости плотности (d) и ТКЛР (α) стеклокристаллических образцов от длительности термообработки (τ) и объемной доли кристаллической фазы в СКМ ($V_{\mbox{\tiny крист.}}/V_{\mbox{\tiny CKM}}$ =f).

Как видно из рисунка, в интервале 6≤т≤24 ч с ростом (резко увеличиваются значения плотности стеклокристаллических образцов. При больших значениях т(≥24 ч) плотности СКМ значительно уменьшаются, а в интервале 36÷42 ч значения d остаются практически неизменными. Ход кривой d-т становится прямолинейным, что свидетельствует о неизменности соотношения между аморфной и кристаллической фазами при выбранных режимах термообработки исходного стекла. В результате исследований выявлено, что существует линейная зависимость между плотностью и соотношением Vкрист./Vскм. В отличие от плотности, зависимость α-f стеклокристаллических образцов нелинейная, и ТКЛР монотонно уменьшается от 87 до 72.0·10⁻⁷°С⁻¹ при значениях f=0.5÷0.85. Нелинейная зависимость значений α от степени кристаллизации стекла, вероятно, обусловлена изменениями координационных состояний бора и алюминия. Исследования проводились до степени кристалличности f≤0.85, а в интервале f=0.85÷1.0 значения d и α определялись с помощью экстраполяции соответствующих кривых. Разница значений плотностей и ТКЛР стеклокристаллического материала, полученного в результате 42-часовой термообработки, и полностью закристаллизованного стекла, определяемая экстраполяцией, невысокая И равна 0.03 *г/см*³ и 2.05·10-⁷°С⁻¹, соответственно. Это позволяет значения d и α (4.85 г/см³ и 70.0.10-70С-1), определенные экстраполяцией соответствующих кривых, с приближенностью некоторой отнести к монокристаллу ВаLа3[F4/AlB3O5]2F7. Значения d и α монокристалла и стеклокристаллического материала с f=0.85 близки и значительно превосходят соответствующие значения исходного стекла (d=3.81 г/см³, α=104.0·10⁻⁷°С⁻¹). Приведенные сравнения позволяют сделать предположение о высокой степени формированности кристаллической структуры СКМ, об отсутствии пористости и разрывов сплошности между кристаллическим и стеклообразным фазами. Об этом косвенно свидетельствуют также кривые ДТА стеклокристаллических образцов, где с ростом f резко уменьшаются интенсивности эндо- и экзотермических эффектов, а соответствующие им температуры смещаются в область высоких температур.

На рис. З приведены зависимости ε -Т и tg δ -T от длительности термообработки и степени кристалличности синтезированных СКМ. Максимумы на кривых ε -Т и tg δ -T получаются в температурном интервале сегнетоэлектрического фазового перехода 425±5°С (точка Кюри). В целом значения ε стеклокристаллических образцов увеличиваются с ростом продолжительности термообработки. Однако выделяющиеся кристаллические фазы на начальном этапе более существенно влияют на диэлектрические свойства: в интервале $\tau \approx 6 \div 24$ ч наблюдается более резкий рост диэлектрической проницаемости, далее ($\tau \approx 24 \div 30$ ч) значения ε увеличиваются плавно. Такой же ход зависимости ε наблюдается от степени кристалличности СКМ: до 70% значения ε увеличиваются резко, а в интервале 70 \div 85% – плавно. Максимальные значения ε (≥ 10000) имеют стеклокристаллические образцы, степень кристалличности которых $\approx 85\%(\tau=30$ ч). В противоположность ε , значения tg δ с ростом τ и степени кристаллизации образцов монотонно уменьшаются, достигнув своих минимальных значений при степени кристалличности $\approx 85\%(\tau=30$ ч.

По данным рентгеноструктурного анализа, соединение BaLa₃[F₄/AlB₃O₅]₂F₇, являющееся основной кристаллической фазой в CKM, кристаллизуется в орторомбической сингонии и имеет следующие параметры пространственной сетки: a=8.96, b=16.7, c=7.8; структурная группа – Pc21n. Основываясь на результаты PCA и ИК-спектроскопических исследований соединения BaLa₃[F₄/AlB₃O₅]₂F₇, предложена возможная пространственная структурная модель данного соединения (рис. 4).



Рис. З. Зависимости ε-T и tgδ-T стеклокристаллических образцов от длительности термообработки (а) и степени кристалличности СКМ (б).

Рис. 4. Пространственная структурная модель соединения BaLa₃[F₄/AlB₃O5]₂F₇.

В заключение следует отметить, что в широком диапазоне температур изучены диэлектрические свойства синтезированных стеклокристаллических материалов, полученных на основе монофазной кристаллизации стекла с составом BaLa₃Al₂B₆(O₁₀,F₁₅). Выявлено, что полученные СКМ отличаются широким температурным интервалом фазового перехода ($\Delta T^{-1}50^{\circ}$ С), высокими значениями диэлектрической проницаемости ($\epsilon \ge 10000$). Стеклокристаллические материалы отличаются сравнительно низкой температурой сегнетоэлектрического фазового перехода ($T_{C} \approx 425 \pm 5^{\circ}$ С) по сравнению с известными аналогами ($T_{C} \approx 520 \div 540^{\circ}$ С) [9,10]. Синтезированы сегнетоэлектрические СКМ нового типа на основе легкоплавкой системы с такой совокупностью свойств, которая создает возможность для их широкого применения в практике.

BaO–B2O3–2AlF3-3LaF3 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱՊԱԿԵԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՍԵԳՆԵՏՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԴԻԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կ. Ա. ՆԱԼԲԱՆԴՑԱՆ

BaO-B₂O₃-2AlF₃·3LaF₃ համակարգում կիրառական նշանակության սեգնետոէլեկտրական նյութերի ստացման ապակեբյուրեղային համար անհրաժեշտ հատկությունների լավագույն համախմբով u բարձր
 ξ
 BaLa3Al2B6(O10F15)
վերարտադրելիությամբ օժտված բաղադրությամբ ապակին։ Ըստ ռենտգենաֆազային անայիզի արդյունքների պարզվել է, որ նշված ապակու բյուրեղացման արգասիքներում առկա են ֆտորբորատային և և LaF₃) բյուրեղային միացություններ, որոնցից ֆտորիդային (AlF₃ BaLa3[F4/AlB3O5]2F7-h (բյուրեղանում է օրթոռոմբիկ սինգոնիայում) բաղադրությունը մոտ է ապակու ստեխիոմետրիկ բաղադրությանը։ Բացահայտվել է, որ ε-ի առավելագույն (≥10000) և էքծ-ի նվազագույն («0.001÷0.0015) արժեքներ ցուցաբերում են ապակեբյուրեղային նմուշները, որոնց բյուրեղացման աստիձանը ~85% է, իսկ τ=30 ժ։ Հիմնվելով BaLa3[F4/AlB3O5]2F7 բյուրեղային միացության ռենտգենակառուցվածքային և ԻԿսպեկտրասկոպիկ հետազոտությունների արդյունքների վրա, մեր կողմից տրվել է նշված միացության հավանական տարածական կառուցվածքի մոդելը։

մշակված ապակեբյուրեղային նյութերն Պարզվել է, որ իրենց դիէլեկտրական և ֆիզիկաքիմիական հատկություններով համադրելի են լայն գործնական կիրառություն գտած մոնոբյուրեղային (մասնավորապես բնական ստիլուէլիտ միներալի բյուրեղագիտական նմանակների (LaBGeO5, LaBSiO5) և սեգնետոկերամիկական նյութերի հետ։ Իսկ սեգնետոէլեկտրական ֆազային զգայիորեն ցածր ջերմաստիմանը $(Tc^{425\pm50}C),$ անզման հայտնի նմանակների (LaBGeO₅՝ Tc ~520÷540⁰C) համեմատ, թույլ է տալիս ստանալ նոր դասի բևեռալին կառուցվածքով ապակեբյուրեղալին սեգնետոէլեկտրական նյութեր հատկությունների այնպիսի համադրությամբ, որը հնարավորություն է ստեղծում դրանք լայնորեն կիրառել տեխնիկայում։

THE DIELECTRIC PROPERTIES AND STRUCTURE OF FERROELECTRIC GLASS-CERAMICS OBTAINED BY MEANS OF DIRECTED CRYSTALLIZATION OF GLASSES OF BaO–B₂O₃–2AlF₃· 3LaF₃ SYSTEM

K. A. NALBANDYAN

M.G. Manvelyan Institute of General and Inorganic Chemistry NAS RA 10, Argutyan Str., 2 District, 0051, Yerevan, Armenia E-mail: nalkar2007@yandex.ru

The directed monophase crystallization of glasses has been realized in the system BaO-B₂O₃-2AlF₃· 3LaF₃. We have chosen two-stage heat treatment for the monophase crystallization of glasses. It has been revealed, that in the investigated system the glass with composition BaLa₃Al₂B₆(O₁₀,F₁₅) has necessary optimal properties for obtaining on its basis the ferroelectric glass-ceramics. The dielectric properties of glass-ceramics (GC) synthesized by means of directed crystallization of the given glass have been researched. The maximal values of ε (\geq 10000) and the minimal values of tg δ (\approx 0.001 \div 0.0015) show the glass-samples, which have ~85 % degree of crystallization and the duration of heat treatment τ = 30 *h*. We have given the possible structural model of the compound BaLa₃[F₄/AlB₃O₅]₂F₇, based on the X-ray structural analysis and IR-spectroscopic investigations of that crystalline compound.

The obtained GC show a large temperature interval of the phase transition ($\Delta T \sim 150^{\circ}$ C), high values of the dielectric constant ($\epsilon \ge 10000$), considerably low temperature of ferroelectric phase transition ($T_{C} \sim 425 \pm 5^{\circ}$ C), compared with the well-known analogs ($T_{C} \sim 520 \div 540^{\circ}$ C). It allows to obtain a new type of ferroelectric GC, which has the great prospect for the future application in practice.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Davis M.J., Vullo P. // Journal of the Americ. Ceramic Society, 2008, v. 91, p. 2878.
- [2] Knyazyan N.B. // Phys. Chem. Glasses, 2003, v. 44, p. 215.
- [3] Jain H. // Ferroelectrics, 2004, v. 306, p. 111.
- [4] MacDowell J.F. // Journal of the American Ceram. Society, 1990, v. 73, p. 2287.
- [5] *Tauch D., Russel C. //* Journal of Non-Crystalline Solids, 2005, v. 351, p. 2294.
- [6] *Оганесян Р.М., Князян Н.Б., Костанян К.А.* // Хим. ж. Армении. 2007, т. 60, №4, с. 648.
- [7] Соколов И.А., Тарлаков Ю.П., Мурин И.В., Пронкин А.А. // Физика и химия стекла, 1999, т. 25, №2, с. 96.
- [8] *Налбандян К.А.* // Хим. ж. Армении. 2011, т. 64, №3, с. 344.
- [9] Сигаев В.Н., Саркисов П.Д., Лопатина Е.В. // Физика и химия стекла, 1996, т. 22, №3, с. 153.
- [10] Стефанович С.Ю., Сигаев В.Н. // Физика и химия стекла, 1995, т. 21, №4, с. 345.